マルチモード青緑色半導体レーザーの 不安定共振器によるモード制御

西岡研究室 吉田 知仁

## 1 序論

高出力な半導体レーザーは図 1(a)のような水平面 の幅が広い導波路をもっている。このような半導体レ ーザーをブロードエリア型半導体レーザーという。ブ ロードリア型半導体レーザーは狭い導波路の半導体 レーザーに比べて導波路内の光密度を小さくするこ とができるため高出力で発振させやすい。一方でこの 広い導波路は図 1(b)のように斜め方向の光の往復が 発生しやすく、これがマルチモード発振の要因となる。 [1]



図 1 (a)ブロードエリア型半導体レーザーの構造図 青色部分が導波路で導波路の高さは 2µm、幅 50~数 百µm (b)導波路中の光往復経路の模式図 赤矢印 が基本 TEM00 横モード、黄色矢印が TEM10 横モー

### ドのもとになる往復

マルチモード発振すると集光性が悪化するが、不安 定共振器を用いるとこれを改善できる。不安定共振器 は往復回数が少なくなるので低利得レーザーでは発 振が難しいが、半導体レーザーは十分に高利得である ため発振するはずである。そこで本研究では戻り光を 利用し、半導体レーザーを不安定共振器に組み込んだ 光学系を用いてビームの集光性を向上させる。青緑色 帯の半導体レーザー媒質である窒化ガリウムは屈折 率が小さいため、戻り光の入力には適性がある。[2]

### 2 光共振器と横モード

### 2.1 安定共振器と横モード

一般的に二枚の鏡を用いた光共振器は図2のような 光を完全に閉じ込めて増幅させる構造をもっている。 光共振の構造によって光の往復パターンは異なり、こ れが出力されたときビーム断面に固有の模様を示す。 これを横モードという。一般的な光学機器は基本横モ ードというビーム断面がガウス関数になっているビ ームに対応しているため、他のモード光が混ざってい るとその分だけその分だけ制御ができなくなる。ビー ムを集光する際には最小スポット径よりも集光径が 大きくなり集光性が悪化する。



図 2 安定共振器の模式図 緑矢印は光の往復パター ンを示している。(a)の往復パターンはミラーに垂直 な基本横モードのみ(b)、(c)は基本横モード以外に も往復パターンがある。

## 2.2 不安定共振器

図のように共振器は光を閉じ込めないようにする と、光の往復は共振器外に向かう。このような共振器 を不安定共振器といい、前述した完全に光を閉じ込め る共振器を安定共振器という。不安定共振器は中心で 往復する光の往復回数が多く、端で往復する光の往復 回数が少ない。これにより共振器の端に比べて中心で 往復する基本横モードの光が増幅されやすくビーム の集光性が向上する。



図 3 不安定共振器の模式図 緑矢印の光がレーザ ー媒質を往復しながら共振器の外に回折している ことを示した。

## 3 不安定共振器による横モード制御実験

3.1 半導体レーザーの横モード制御をするための不 安定共振器の構成

半導体レーザーはその導波路の形状から横モード は高速軸ではシングルモード、低速軸でマルチモード 発振する。横モード制御する際は低速軸のみの制御で よい凹面鏡ではなく凹面シリンドリカルミラーを用 いた。以下に不安定共振器に用いた光学器具を示す。

- 青色半導体レーザー 450nm
  L450P1600MM(Thorlabs)
- コリメートレンズ 焦点距離 4 mm 352610-A(Thorlabs)
- シリンドリカルミラー1 焦点距離 100 mm

CCM254-100-P01(Thorlabs)

 シリンドリカルミラー2 焦点距離 200 mm CCM254-200-P01(Thorlabs)

# 3.2 半導体レーザーの横モード制御するための不 安定共振器の原理



## 図 3 本研究で設計した不安定共振器 (a)はコンセプ トデザイン (b)は(a)の改良系

本研究で設計した不安定共振器を図3に示した。 図4(a)のように不安定共振器を組むと凸面シリンド リカルミラーの入手性が悪いため特注になる。また 不安定共振器の回折光をコリメートするために穴の 開いた凹面シリンドリカルミラーを用意する必要が ある。そこで図4(b)のように凹面シリンドリカルミ ラーを不安定共振するように配置して、またシリン ドリカルミラーの端で反射させることで回折光を特 殊な形状のミラーを使わないでコリメートすること ができる。

## 3.3 ビーム径測定方法

ビーム径は高出力光に対応するためにナイフエッ ジスキャンを行う。ナイフエッジ法はビームをナイ フのような鋭いもので一部を遮ってゆきその出力を 測定する。この遮ったナイフの移動距離と出力を利 用してビーム径を求めることができる。 ビーム径を求めるにあたって本測定ではガウシア ンビーム ( $f(x) = e^{-2}$ )の強度分布における最大出力の  $e^{-2}$ となる二点の距離を径とした。これは本測定がビ ーム質を改善することにあり、品質の基準となるガウ シアンビームの径が一般的にこの値を用いて測定さ れるためである。図はガウス関数 $f(x) = \exp(-x^2)$ で あるが、最大出力の $e^{-2}$ となるのは $x = \pm\sqrt{2}$ となるとき であるためこのときビーム径は $2\sqrt{2}$ である。



ナイフエッジスキャンではガウス関数の積分系が 取れるため、測定結果は図 5 のようなデータになる。 このデータからe<sup>-2</sup>径を求めるとき、ガウス積分の値 を計算する。積分範囲[-a,a]のときのガウス積分の値 は次式のようになる。

$$g(a) = \int_{-a}^{a} f(x) dx = 2 \int_{0}^{a} e^{x^{-2}} dx$$
$$= \sqrt{2 \arctan a}$$

これは出力の比率であるため、係数を求める。g(a)がとりうる最大の大きさ $a = \infty$ のときと $a = \sqrt{2}$ のときの比はビーム径の出力とできる。

$$\frac{g(\sqrt{2})}{g(\infty)} = 0.7798$$

より、ナイフエッジ法で求めるべき距離は全光出力の 1-(1-0.779)/2=89 %、(1-0.7789)/2=11%となる二点 となり、これが強度分布のピーク値のe<sup>-2</sup>倍になるビ ーム径である。



3.4 回折限界スポット径



### 図 6 回折限界

回折限界スポット径とはガウシアンビームを集光 したときの最小径のことである。ガウシアンビーム ではないビームを集光するとこの値より最小径が大 きくなるため、集光したときの最小径が小さいほど ガウシアンビームに近い理想的なビームといえる。 この回折限界スポット径を2ω<sub>0</sub>、レンズの開口径を D、レンズの焦点距離をf、ビーム拡がり角を2θとす る。このときθはガウシアンビームであることから次 式がわかっている。

$$\theta = \frac{\lambda}{\pi\omega_0}$$

またθが十分に小さいことにより

$$\theta \simeq \tan \theta = \frac{D}{2f}$$
 が導出できるので

回折限界スポット径2ωoを求める。

$$2\omega_0 = \frac{4f\lambda}{D\pi}$$

4 半導体レーザーの不安定共振器による低速 軸の横モード制御実験結果

4.1 低速軸の横モード制御

駆動電流 200mA、焦点距離f = 480mmのときの不 安定共振器あり、なしでナイフエッジスキャンした。



	(遠視野ビーム径)/
	(回折限界スポット径)
不安定共振器あり	1.1
不安定共振器なし	1.3

図7、8から遠視野ビーム径2ω<sub>0</sub>と近視野ビーム径D を求めて回折限界スポット径を計算した。集光性の基 準として遠視野ビーム径から回折限界スポット径を 割ったものを使用することにした。不安定共振器を用 いると集光性が向上したことを確認できた。



不安定共振ありとなしでは出力がどう変化するの かを調べ図9に示した。不安定共振器を利用した方は 出力効率がかなり悪くなっている。この原因として考 えられるのは戻り光である。窒化ガリウムは青緑帯で 屈折率の小ささを利用して光を戻しているが、屈折率 が小さいため戻り光が反対側の端子面から漏れてい る可能性がある。よっては戻り光の量を減らすように ミラーの曲率半径を変えれば出力改善の見込みはあ る。

### 5 結論

不安定共振器により横モード制御を行うことでブ ロードエリア型半導体レーザーの集光性を向上させ ることができた一方で、出力効率は大幅に低下した。 この出力効率低下は戻り光が消滅することで発生し ていると考えられるので、集光性向上の最低限の量の 戻り光を見つけてシリンドリカルミラーの最適な曲 率半径を調べる必要がある。

### 参考文献

[1] A. E. Siegman, "LASERS," University Science Books, (1986).

[2] J. Lingrong, L. Jiaping, T. Aiqin, C. Yang, Li Zengcheng, Z. Liqun, Z. Shuming, L. Deyao, M. Ikeda and Y. Hui, "GaN-based green laser diode," *Journal of Semiconductors*, **37**, p.111001, (2016).

## 4.2 出力特性